

Установка плазмохимического осаждения LAPECVD

Установка плазмохимического осаждения LAPECVD

Производитель:

Plasma-Therm

Цена:

Цена по запросу

Описание

Plasma-Therm LAPECVD — это специально разработанная высокопроизводительная установка плазмохимического осаждения диэлектрических покрытий. Plasma-Therm LAPECVD, как правило, используется на серийном производстве. Установка оснащена автоматическим загрузочным устройством, позволяющим работать «из кассеты в кассету». Особенностью установки является специальная камера и электрод, благодаря которым осуществляется групповая обработка подложек. Установка Plasma-Therm LAPECVD оптимально подходит для осаждения диэлектриков SiO₂, SiN_x, SiO_xN_y.

Ключевые преимущества установки LAPECVD:

- Высокопроизводительная установка для осаждения SiO₂, SiN_x, SiO_xN_y.
- Максимальный размер обрабатываемой подложки — до 3×200 мм; групповая обработка.
- Равномерность осаждаемого покрытия по толщине и воспроизводимость результатов от пластины к пластине — лучше ±2%.
- В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных технологических процессов, которые гарантируются производителем.
- Простой, интуитивно понятный интерфейс.
- Программное обеспечение позволяет записывать параметры процессов для дальнейшего анализа.
- История аварийных сообщений, контроль рецептов в процессе работы — вывод данных о процессе на дисплей в режиме реального времени.
- Многоуровневый доступ пользователей.
- Возможность удаленного управления и контроля состояния системы.
- Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания процесса (OES, OEI, LEPD).
- Простота использования и обслуживания.
- Малая занимаемая площадь.
- Возможность установки через стену чистого производственного помещения.